

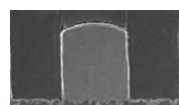
石巻第二工場 技術ロードマップ

Ishinomaki Factory No.2 Technology Roadmap

FY2025			FY2025		FY2026		FY2027	
			HVM	Proto Type	HVM	Proto Type	HVM	Proto Type
Max Build-up Layer Count			9	10	←	12	←	←
Max Via Stack			6	10	←	12	←	←
Trace	BU L/S (SAP)		8/8	7/7	←	6/6	←	5/5
	BU Trace Thickness		12	10	←	8	←	6
	Core L/S (Subtractive)		45/45	←	←	40/40	←	40/40
Via/Land	BU	Via	φ50	←	←	φ45	←	φ40
		Land	φ80	φ75	←	φ70	←	φ70
PTH/Land	Core Thickness	0.4mm	φ105/200	←	←	←	←	105/200
		0.8mm	φ105/200	←	←	←	←	105/200
		1.2mm	φ150/250	←	←	←	←	150/250
		1.4mm	φ200/300	←	←	←	←	200/300
SR	Opening (μm)		φ65	φ60	←	φ55	←	φ50
	Cu Pad (μm)		φ90	φ85	←	φ80	←	φ75
SOP	Min Bump Pitch (μm)		120	110	←	100	←	90
Material	Core		E-700G (R) E-705G E-795G R-1515V	HL832RS (LCA) HL832NSA (TLC)	E-700G (R) E-705G E-795G R-1515V HL832RS (LCA) HL832NSA (TLC)	TBD	E-700G (R) E-705G E-795G R-1515V HL832RS (LCA) HL832NSA (TLC)	TBD
	BU (ABF)		GX92 GXT31 GL102F	GL107-2N NX04H NQ07XP	GX92 GXT31 GL102F GL107-2N NX04H NQ07XP	TBD	GX92 GXT31 GL102F GL107-2N NX04H NQ07XP	TBD
	SR	Liquid	SR7300G SR7400A	TBD	SR7300G SR7400A	TBD	SR7300G SR7400A	TBD
		Film	—	SR-FK SR1	SR-FK SR1	TBD	SR-FK SR1	TBD

回路仕上り

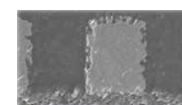
短形形状 : 低シード層残渣
低アンダーカット : 細線対応
低粗化CZの採用 : 高周波数対応



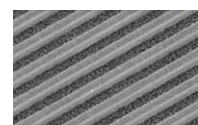
パターンめっき後



FE後



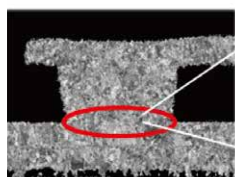
CZ後



L/S=7/7

Via仕上り

Via接続 : マイクロボイドレス



パターンめっき前処理強化



X35,000

IVH

業界最狭PTHピッチ対応



縦型真空印刷機 (治具レス対応)

